8.1.4 Merkpunkte zu Kapitel 8.1: Leitfähigkeit, Ladungsträgerdichte und Beweglichkeit

- Das Ohmsche Gesetz ist nur sinnvoll für spezifische Größen:
 - j = Stromdichte
 - <u>E</u> = Feldstärke .
 - Wesentliche Materialkonstante ist: Leitfähigkeit σ oder spez.
 Widerstand ρ.

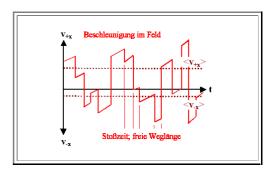
 $j = \sigma \cdot \underline{E}$ $\sigma = 1/\rho$

- Man muss mit den ca. 1 μ Ω cm guter reiner Metalle (Ag, Cu) leben, man kann sie immer nur verschlechtern (Defekte , Legieren, ...), aber nie besser machen.
- ρ (Metall) \approx 1 μ Ω cm ρ (Halbleiter) \approx 1 Ω cm ρ (Isolator) \approx 1 G Ω cm

 $i = q \cdot n \cdot \underline{v}_D$

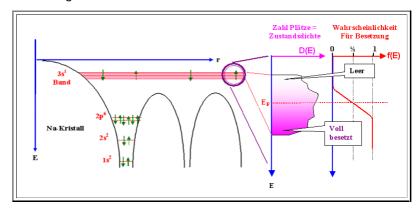
- Elektrische Stromdichte ist ein Nettostrom geladener Teilchen, gegeben durch Zahl der Ladungen = Teilchen, die pro Sekunde mit einer mittleren Nettogeschwindigkeit v durch einen cm² fließen.
 - Das läßt sich immer so schreiben ⇒
 - Die Driftgeschwindigkeit vD, verursacht durch das elektrische Feld, ist aber extrem klein gegenüber der mittleren thermischen Geschwindigkeit vtherm
 - Für die Leitfähigkeit ergibt sich sofort ⇒
 - Damit ist ein neuer, sehr wichtiger Materialparameter, die Beweglichkeit μ definiert.
 - Das Ohmsche Gesetz ist nun hergeleitet, in der "Materialform" schreibt es sich ⇒
- $\sigma := \frac{q \cdot n \cdot v_D}{E} = \text{constant}$ $\frac{v_D}{E} =: \mu = \text{constant}$ E $\sigma = q \cdot n \cdot \mu$
- Die Dichten n_{Met} der Ladungsträger in Metallen n_{Met} und Isolatoren n_{Iso} sind von der Größenordnung her bekannt: Ungefähr Dichte Atome bzw um Null.
 - Es bleibt, die Beweglichkeit μ zu bestimmen
 - Bei Halbleitern ist n_{Halb} noch nicht klar, hier brauchen wir n_{Halb} und
 μHalb.
- n_{Met} ≈ Atome n_{lso} ≈ 0

- Eine relativ simple Betrachtung des Herumwuselns von Elektronen in Kristallen ergibt folgende Beziehungen:
 - Stöße zwischen Elektronen und den den Haupstoßpartner "Phononen" = Träger der thermischen Energie = anderes Wort für (quantisierte) Gitterschwingungen und Kristallgitterdefekten (Fremdatomen, Korngrenzen, Versetzungen, Ausscheidungen, ...) sorgen für eine im Mittel konstante Driftgeschwindigkeit.
 - Charakteristische Parameter dazu sind die (mittlere) Stoßzeit τ und die mittlere freie Weglänge I = ντ.
 - Die Beweglichkeit ist dann direkt gegeben (d.h. proportional) zu *I* = ντ oder τ. (Formel muss man nicht wissen).
- Die Temperatur bestimmt klassisch sowohl v (über ½mv² = 3/2 k_BT) als auch (über Stöße mit "Phononen") zum Teil die Beweglichkeit.



Es kommt Unsinn raus!

- Für eine gegebene Elektronendichte (z. B. typisches Metall) und eine gemessene Leitfähigkeit kann man damit alle Größen ausrechnen, aber ⇒
- Pauli-Prinzip!
- Elektronen können nicht mit beliebigen Geschwindigkeiten = Energie
 Zuständen existieren; sie können z. B. nicht alle bei T = 0 K
 bewegungslos sein.
- Der Gleichverteilungssatz gilt nicht für Fermionen!
- Trotzdem behalten alle obigen Formeln außer ½mv² = 3/2 kBT auch in der nachfolgenden "richtigen" Betrachung ihre Bedeutung wir müssen nur die Geschwindigkeit richtig bestimmen.
- Wir müssen die möglichen Zustände für Elektronen (in Metallen) und die Besetzung dieser Zustände als Funktion der Temperatur betrachten Das nachfolgende Bild enthält die relevante Information:



- Die Elektronenzustände im Metall (Kristall!) formen ein "Band" wie bereits bekannt und hier nochmal gezeigt.
- Von Interesse sind die möglichen Energieniveaus im Band (= richtige Energie der herumwuselnden Elektronen). Das wird am einfachsten durch den neuen Begriff Zustandsdichte erfaßt.
- Entscheidend ist, welche Zustände mit Elektronen besetzt sind. Das regelt die (bereits bekannte) Fermi-Verteilung.

Zustandsdichte D(E) · dE = Zahl der Zustände bei E im Intervall dE pro cm³

- Nur Elektronen im "Aufweichungsbereich" der Fermiverteilung sind "handlungsfähig", d. h. nur sie können auf elektrische Felder durch Zustandsänderung reagieren.
 - In anderen Bereichen gibt es entweder keine Elektronen (z. B. hohe Energie) oder sie haben keine freien Plätze in der Nachbarschaft (kleine Energiedifferenz), auf die sich "ändern" könnten.
 - Damit folgt eine weitreichende Aussage ⇒

Die Bandstruktur der Elektronen in einem Kristall, d. h. D(*E*), bestimmt die elektronischen Eigenschaften!